

Unidade PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA	Área NANOELETRÔNICA E CIRCUITOS INTEGRADOS
Disciplina PEL104 – Caracterização Elétrica de Dispositivos MOS	Tipo Optativa
Carga Horária 4 horas semanais em 12 semanas	
Objetivos Apresentar as principais estruturas de caracterização elétrica e métodos de medidas das principais características elétricas dos transistores MOS.	
Metodologia Adotada Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratório.	
Recursos necessários Sala de Aula e Laboratório de Caracterização de Dispositivos Eletrônicos.	
Programa para 12 semanas 1. Capacitores MOS; 2. Capacitores MOS; 3. Capacitores MOS; 4. Capacitores MOS – Experimental; 5. Funcionamento dos transistores MOS; 6. Funcionamento dos transistores MOS; 7. Principais características elétricas dos transistores MOS; 8. Transistores MOS – Experimental; 9. Diodos; 10. Diodos – Experimental; 11. Estruturas para caracterização de processos; 12. Estruturas para caracterização de processos – Experimental.	
Método de Avaliação Provas e Trabalho Final.	
Bibliografia Básica - J. A. Martino, M. A. Pavanello e P. B. Verdonck, Caracterização Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS, Editora Thomson Learning, 2003.	

Atualizada: 07/2011